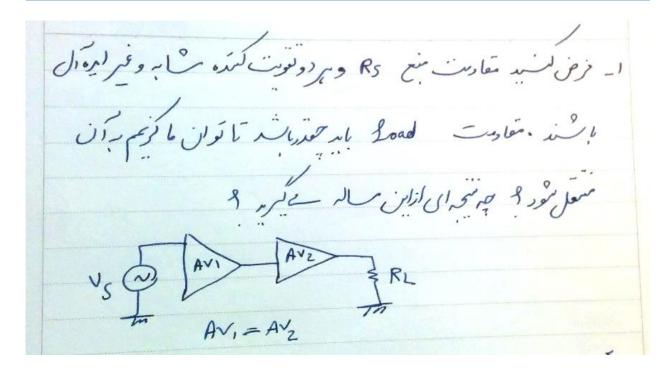
سرى سوم تكاليف درس اصول الكترونيك 27 بهمن 1393



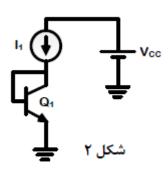
ر مدار شکل ۲، بیس ترانزیستور Q_1 به کالکتور آن وصل شده است. به ترانزیستور با این نوع - اتصال، ترانزیستور با اتصال دیودی (Diode Connected) می گوییم. این ترانزیستور توسط یک منبع $I_s = 0.1 \ fA$) جریان ایده آل $I_s = 0.1 \ fA$)

الف) ناحیه یکار (قطع، اشباع، اکتیو) ترانزیستور Q_1 چه می باشد؟

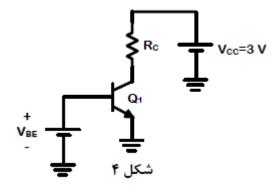
با فرض 100 $\beta = 1$ جریان کالکتور Q_1 را محاسبه کنید.

ج) رابطه ی I-V را برای ترانزیستور Q_1 نوشته و نشان دهید که Q_1 نظیر یک دیود عمل می کند.

د) مدل سیگنال کوچک را برای Q_1 بدست آورید.



را تکرار PNP برای مساله ی ۴ شکل مدار را برای وقتی که Q_1 از نوع PNP است رسم کرده و مساله ی ۴ را تکرار کنید.



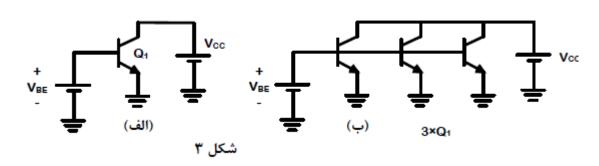
ج در مدار شکل ۳- الف مقدار $I_{\rm s}$ ترانزیستور برابر A^{-16} و B=100 میباشد.

الف) مقدار V_{BE} را برای آنکه $I_{C}=0.1~mA$ باشد، محاسبه نمایید.

بدست آورید. Q_1 مدار معادل سیگنال کوچک را برای Q_1 بدست اورید.

ج) اگر هر سه ترانزیستور شکل $^{-}$ ب معادل Q_1 باشند و V_{BE} همان مقدار محاسبه شده در قسمت الف را داشته باشد، مدار معادل سیگنال کوچک هر ترانزیستور و مدار حاصل از موازی کردن آنها را بدست آورید.

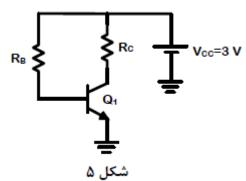
د) مقدار V_{BE} در شکل P_{BE} برای آن که مدار معادل سیگنال کوچک حاصل همان مدار معادل سیگنال کوچک مدار شکل P_{BE} الف باشد را محاسبه کنید.



در مدار شکل ۵، 0.7
$$V_{BE}=0.7$$
 و $eta=0$ میباشد. $oldsymbol{-}oldsymbol{\wedge}$

الف) مقدار R_B را برای آنکه $I_C=1\,mA$ شود، محاسبه نمایید.

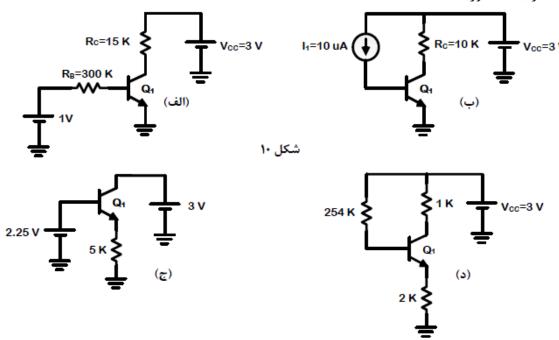
ب) اگر $R_C=1.5~K$ و $V_{CE}(sat)=0.2~V$ باشد مقدار R_B برای آنکه در مرز ناحیه ی اشباع قرار گیرد، $V_{CE}(sat)=0.2~V$ و عدر است؟



برای مدارهای شکل $I_S=10^{-16}\,A$ و $I_S=10^{-16}\,$ میباشد.

الف) نقطهی کار ترانزیستورها را محاسبه کنید.

ب) پس از محاسبه ی نقطه ی کار با فرض $V_A = 30$ ، مدل سیگنال کوچک را برای ترانزیستورهای هر مدار بدست آورید.



با تشکر از آقای دکتر شریف بختیار